

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年6月27日(27.06.2024)



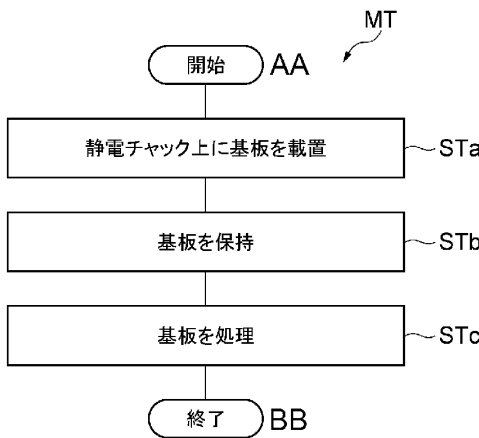
(10) 国際公開番号

WO 2024/135476 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/31 (2006.01) H01L 21/683 (2006.01)
C23C 14/12 (2006.01) H01L 21/3065 (2006.01)
C23C 16/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/044527
- (22) 国際出願日: 2023年12月12日(12.12.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-204339 2022年12月21日(21.12.2022) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 川端 淳史 (KAWABATA Atsushi); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 宮川 正章(MIYAGAWA Masaaki); 〒1838705 東京都府中市住吉町2-30-7 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 斉 ツォン(SAI Chong); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外(HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING METHOD, SUBSTRATE PROCESSING DEVICE, AND SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM

(54) 発明の名称: 基板処理方法、基板処理装置、及び基板処理システム



STa Place substrate on electrostatic chuck
STb Hold substrate
STc Process substrate
AA Start
BB End

(57) Abstract: Disclosed is a substrate processing method comprising a step for placing a substrate on an electrostatic chuck of a substrate support portion of a substrate processing device. The electrostatic chuck has a substrate support surface. The substrate includes a back surface and an organic layer which is formed on the back surface in advance. The substrate is placed on the electrostatic chuck so that the organic layer contacts the substrate support surface. The substrate processing method further comprises a step for holding the substrate by electrostatic attraction of the electrostatic chuck. The substrate processing method further comprises a step for processing the substrate in the substrate processing device.

(57) 要約: 開示される基板処理方法は、基板処理装置の基板支持部の静電チャック上に基板を載置する工程を含む。静電チャックは、基板支持面を有する。基板は、裏面及び該裏面に予め形成された有機層を含む。基板は、有機層が基板支持面に接するように静電チャック上に載置される。基板処理方法は、静電チャックによる静電吸着により基板を保持する工程を更に含む。基板処理方法は、基板処理装置において基板を処理する工程を更に含む。

[続葉有]

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))